
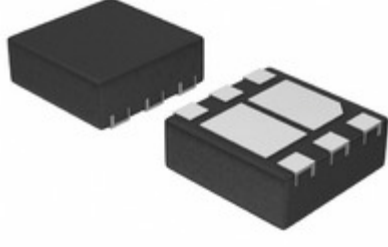
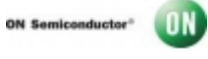


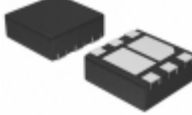
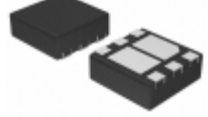
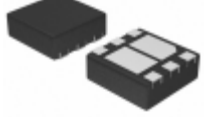
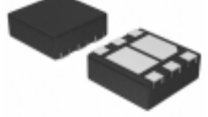
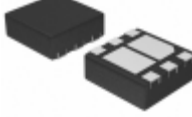
	<h2 style="color: red;">NTLJD3119CTAG</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: NTLJD3119CTAG</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N/P-CH 20V 6WDFN</p> <p>Datenblätter:  NTLJD3119CTAG.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 41964 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	NTLJD3119CTAG
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N/P-CH 20V 6WDFN
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	41964 pcs Stock
Serie	μ Cool™
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	710mW
Verpackung / Gehäuse	6-WDFN Exposed Pad
Supplier Device-Gehäuse	6-WDFN (2x2)
Typ FET	N and P-Channel
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.6A, 2.3A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	65 mOhm @ 3.8A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250 μ A
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	3.7nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	271pF @ 10V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

NTLJD3119CTAG ist neu im Original, Suche NTLJD3119CTAG Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTLJD3119CTAG AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTLJD3119CTAG: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>NTLJD2105LTBG AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N/P-CH 8V 2.5A 6-WDFN</p>	 <p>NTLJD3119CT1G ON NTLJD3119CT1G ON</p>	 <p>NTLJD3115PT ON NTLJD3115PT ON</p>	 <p>NTLJD3119CTBG AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N/P-CH 20V 6WDFN</p>
 <p>NTLJD3182FZTAG AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 2.2A 6-WDFN</p>	 <p>NTLJD3115PTAG AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2P-CH 20V 2.3A 6-WDFN</p>	 <p>NTLJD3115PT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2P-CH 20V 2.3A 6-WDFN</p>	 <p>NTLJD3181PZTBG AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2P-CH 20V 2.2A 6WDFN</p>

heiße Teile

Mehr

 AD7691BRMZ	 B3FS-1000P	 BD7851FP	 CGA3E2X7R1H472K080AD	 CSRS3661A01-IBBO-R
 CY2305SXC-1	 IRFH4213DTRPBF	 LCMXO1200C-3FT256C	 LQH2MCN470K02L	 MAX6866UK26D3S+
 MCC25-08i01	 NTLGD3502NT1G	 NTLGD3502NT2G	 NTLJ3113PT1G	 NTLJD2105LTBG
 D NTLJD3115PT1G	 NTLJD3115PTAG	 NTLJD3119CT1G	 NTLJD3119CTBG	 NTLJD4116NT1G
 NTLJF3117PT1G	 NTLJF4156NT1G	 NTLJF4156NTAG	 NTLJS2103P	 NTLJS2103PTAG
 NTLJS2103PTBG	 NTLJS3113P	 D NTLJS3113PT1G	 NTLJS3113PTAG	 NTLJS3A18PZTWG
 NTLJS4114NT1G	 D NTLJS4114NTAG	 NTLJD4901NF	 NTLJD4901NFTWG	 NTLTD7900NR2G
 NTLTD7900ZR2	 NTLTD7900ZR2G	 NTLUD3A260PZTAG	 NTLUD3A50PZTAG	 NTLUF4189NZTAG
 NTLUS3A18PZTAG	 NTLUS3A40PZTAG	 NTLUS3A40PZTBG	 D NTLUS3A90PZTAG	 NTLUS4930NTAG
 PM10DHA120-1	 PQ1CY1032	 S-80850CLNB-B7BT2U	 SN65LVCP22PWR	 SSTDPAD100

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited